



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HA1695

对应国外型号
2SA1695

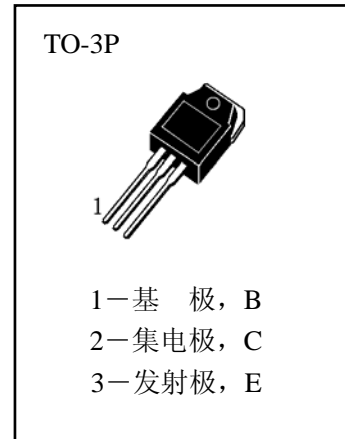
■ 主要用途

音频功率放大。与 HC4468 互补。

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150°C
T_j ——结温	150°C
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	100W
V_{CBO} ——集电极—基极电压	-140V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	-140V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	-6V
I_C ——集电极电流 (DC)	-10A
I_B ——基极电流	-4A

■ 外形图及引脚排列



■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-140			V	$I_C=-100\mu\text{A}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-140			V	$I_C=-50\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-6			V	$I_E=-100\mu\text{A}, I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	μA	$V_{CB}=-140\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-10	μA	$V_{EB}=-6\text{V}, I_C=0$
$H_{FE}(1)$	直流电流增益	50		180		$V_{CE}=-4\text{V}, I_C=-3\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	$I_C=-5\text{A}, I_B=-0.5\text{A}$
f_T	特征频率		20		MHz	$V_{CE}=-12\text{V}, I_E=0.5\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		400		pF	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$

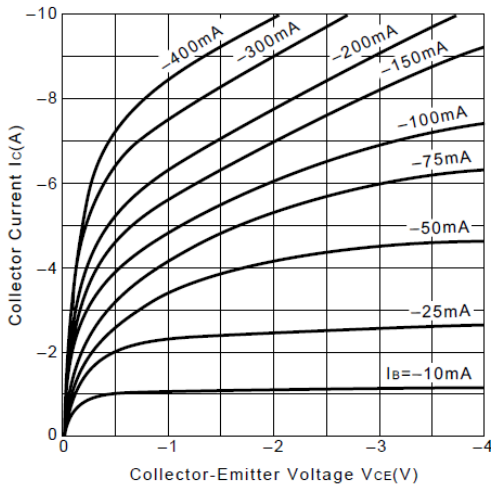
■ HFE (1) 分档及其标志

0	P	Y
50—100	70—140	90—180

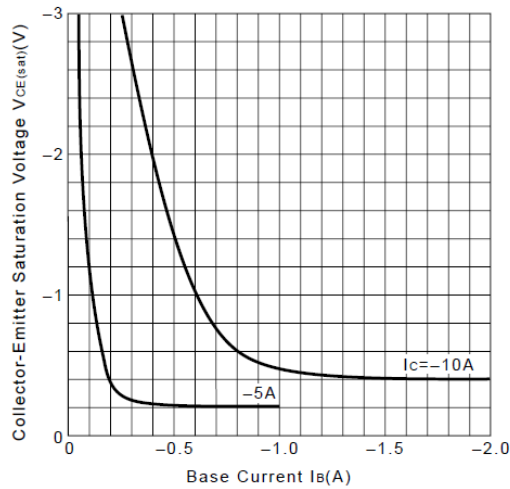


典型特性曲线

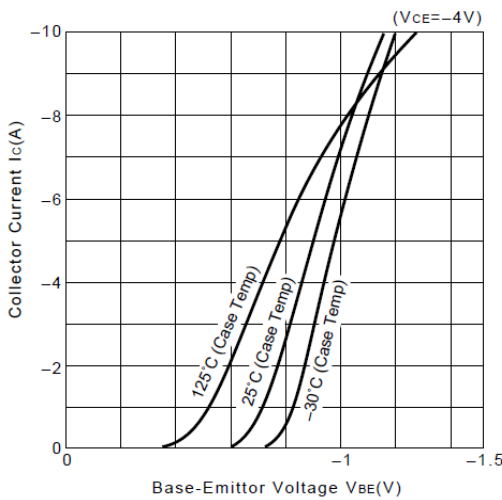
I_c-V_{CE} Characteristics (Typical)



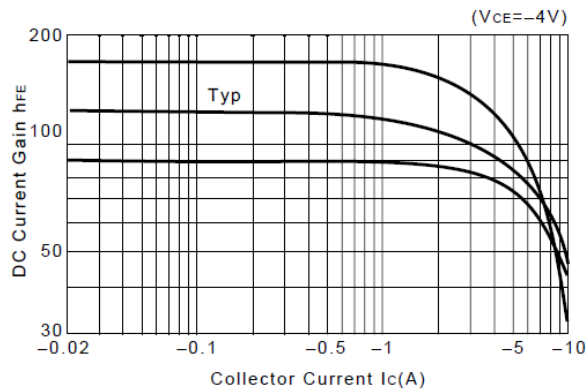
$V_{CE(sat)}-I_b$ Characteristics (Typical)



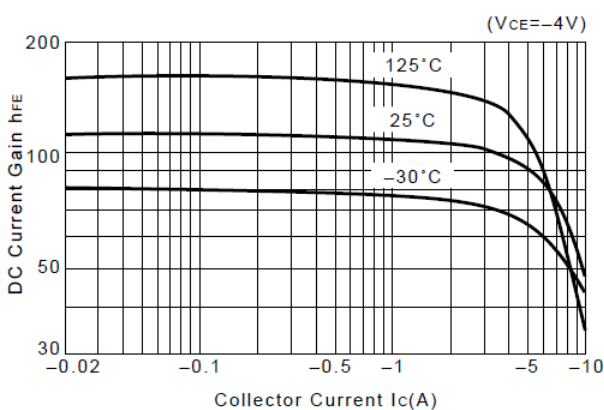
I_c-V_{BE} Temperature Characteristics (Typical)



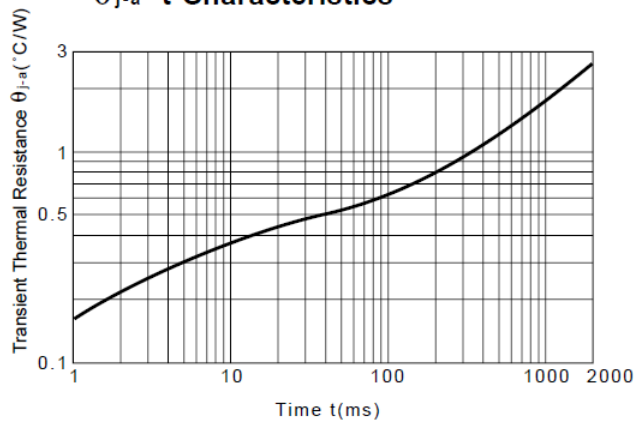
$h_{FE}-I_c$ Characteristics (Typical)



$h_{FE}-I_c$ Temperature Characteristics (Typical)



$\theta_{j-a}-t$ Characteristics





汕头华汕电子器件有限公司

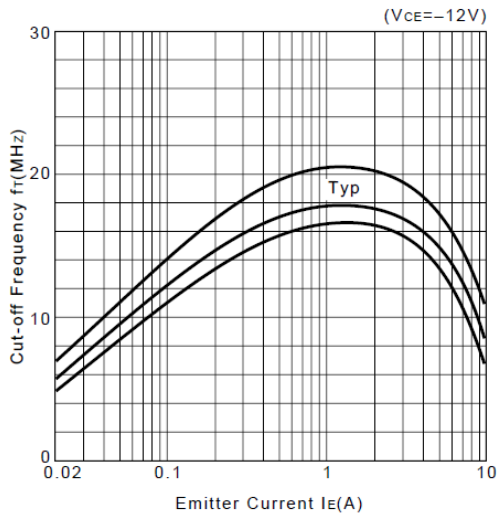
PNP SILICON TRANSISTOR

HA1695

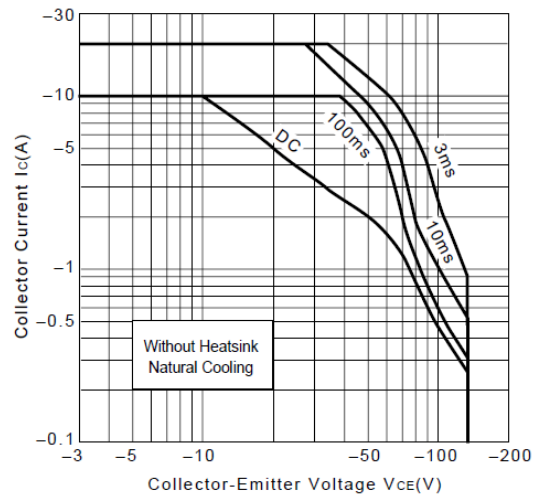
对应国外型号
2SA1695

典型特性曲线

f_T - I_E Characteristics (Typical)



Safe Operating Area (Single Pulse)



P_c - T_a Derating

